

Βιογραφικό Σημείωμα

Όνομα	Αλκυόνη Μάντζαρη
Θέση	Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.
Σπουδές	<ul style="list-style-type: none"> • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ, τίτλος διατριβής: «Μελέτη των δομικών ιδιοτήτων 3C-SiC, κατάλληλου για ημιαγωγικές διατάξεις» (2008) • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στο ΠΜΣ «Φυσική Υλικών», Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ. (2001) • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ. (1998)
Επιστημονική Εμπειρία	<p>2014–σήμερα: Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.</p> <p>2011–2015: <u>ITN Marie-Curie action</u>: «Training Network on Functional Interfaces for Silicon Carbide-NetFISiC» <u>Ερευνήτρια</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Μέλος της επιστημονικής ομάδας <p>2007–2010: <u>RTN Marie-Curie project</u>: «Promoting and structuring a Multidisciplinary Academic-Industrial Network through the heteropolytype growth, characterization and applications of 3C-SiC on hexagonal substrates-MANSiC» <u>Ερευνήτρια</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Μέλος της επιστημονικής ομάδας <p>2005-2007: <u>Κοινό Ερευνητικό και Τεχνολογικό πρόγραμμα Ελλάδας-Γαλλίας</u>: «Μελέτη του μηχανισμού ελάττωσης των σφαλμάτων δομής του κυβικού SiC (3C-SiC) κατά την κρυσταλλική του ανάπτυξη» <u>Κύρια Ερευνήτρια</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Παραγωγή επιστημονικών παραδοτέων ▪ Συγγραφή τελικής έκθεσης <p>2002-2005: <u>Ευρωπαϊκό πρόγραμμα</u>: «Κυβικό SiC για νέες ημιαγωγικές διατάξεις (SOLSiC)» <u>Κύρια Ερευνήτρια</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Παραγωγή επιστημονικών παραδοτέων ▪ Συγγραφή τελικής έκθεσης
Ερευνητικό Έργο	<ul style="list-style-type: none"> • 14 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές • 18 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων • 20 παρουσιάσεις σε συνέδρια/σχολεία
Πέντε Κυριότερες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις	<p>1. On the nanoscaled defects of 3C-SiC <u>A. Mantzari</u>, A. Andreadou, N. Chandran, M. Marinova and E. K. Polychroniadis Int. J. Nanotechnol. Vol. 11, (2014) 539-548</p>

	<p>2. Influence of Ga doping on the micro-structure of 3C-SiC layers grown on 4H-SiC substrates by VLS mechanism</p> <p>M. Marinova, <u>A. Mantzari</u>, A. Andreadou, J. Lorenzzi, G. Ferro and E. K. Polychroniadis</p> <p>Phys. Status Solidi C 10, (2013) 72-75</p> <p>3. Some recent results on the 3C-SiC structural defects</p> <p>Maya Marinova, <u>Alkyoni Mantzari</u> and Efstathios K. Polychroniadis</p> <p>Solid State Phenomena Vol. 159, (2010) pp 39-48</p> <p>4. A TEM study of in-grown stacking faults in 3C-SiC layers grown by CF-PVT on 4H-SiC substrates</p> <p>Maya Marinova, Frederic Mercier, <u>Alkioni Mantzari</u>, Irina Galben, Didier Chaussende and Efstathios K. Polychroniadis</p> <p>Physica B: Condensed Matter 404, (2009) 4749-4751</p> <p>5. Prospects for 3C-SiC Bulk Crystal Growth</p> <p>D. Chaussende, F. Mercier, A. Boulle, F. Conchon, M. Soueidan, G. Ferro, <u>A. Mantzari</u>, A. Andreadou, E.K. Polychroniadis, C. Balloud, S. Juillaguet, J. Camassel, M. Pons</p> <p>Journal of Crystal Growth 310, (2008) 1799-1803</p>
--	--